

南通富士通微电子股份有限公司 与富士通半导体株式会社签署 WLP 技术许可协议暨关联交 易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于：

1. 富士通(中国)有限公司是公司的第二大股东，目前其持股比例为 24.62%。
2. 富士通半导体株式会社与富士通（中国）有限公司同为富士通株式会社的全资子公司，同受富士通株式会社控制。

因此，富士通半导体株式会社为公司的关联方，公司与其签署 WLP 技术许可协议构成关联交易。

本次关联交易涉及到公司晶圆级封装工艺等技术的开发，对于公司生产经营较为重要；同时，2011 年公司应支付的技术许可费金额，不属于公司股东大会关联交易审批权限，因此将本次关联交易提交董事会审议。

公司三届二十二次董事会审议通过了《关于与富士通半导体株式会社签署 WLP 技术许可协议的议案》，同意公司与富士通半导体株式会社签署 WLP 技术许可协议，在本次董事会上，关联董事柏木茂雄先生、河野通有先生、福井明人先生进行了回避。

本次关联交易的主要情况如下：

一、关联交易概述及关联交易标的的基本情况

2010 年 5 月，公司与富士通半导体株式会社签署了 BUMP 许可协议，协议签订后，公司第一条圆片级 BUMP 生产线成功建成，并生产出合格样品，使得公司实现了圆片级封装的成功起步。

在 BUMP 生产线成功量产的基础上，公司欲以市场为导向，积极发展圆片级 WLP 先进封装技术。为实现 WLP 产品更快量产，取得更好收益，公司拟与富士通半导体株式会社合作，借鉴其在圆片级封装技术上的先进经验，同时为配

合卡西欧微电子株式会社的 WLP 技术产品转移合作，将之作为整体项目推进，以期更早达到预定效益和产出。

在此基础上，经与富士通半导体株式会社友好协商，拟签署《WLP 技术许可协议》，相关许可的标的为：富士通半导体株式会社所拥有的 8 英寸 WLP 技术。

二、关联方介绍

富士通半导体株式会社的基本情况：富士通半导体株式会社为富士通株式会社在日本的全资子公司，成立于 2008 年 3 月，其地点位于日本神奈川县横滨市港北区新横滨 2-10-23。富士通半导体株式会社以 LSI 的设计、开发、制造、销售等相关服务为主要业务。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

经公司三届二十二次董事会审议通过，公司拟于近期与富士通半导体株式会社签署 WLP 技术许可协议，该协议主要内容如下：

1. 富士通半导体株式会社授予公司设计、制造和销售包含 8 英寸 WLP 工艺产品的许可。
2. 公司应支付的许可费用分为两部分：1) 入门费：200 万美金；2) 提成费：在支付入门费后三年或最迟协议签订后五年，按季支付提成费直至付满 200 万美金。
3. 上述费用由双方依据市场定价的原则协商确定，定价公允，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响。

四、关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响

本次签署 WLP 技术许可协议是继 BUMP 合作后，与富士通半导体株式会社新一轮的高端技术的合作，体现了富士通对公司长远发展的支持，将加快发展公司圆片级封装技术，提高圆片封装市场的份额，并进一步适应世界级封装测试企业发展的需要。同时，有助于加快卡西欧微电子技术产品的转移，尽早实现产出及收益。

五、2011年1月1日至5月31日，公司与富士通株式会社及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额约为5,356万元。

六、独立董事以及保荐机构意见

（一）独立董事发表的独立意见

本公司独立董事认为公司与富士通半导体株式会社签署WLP技术许可协议确系出于业务经营的需要，关联交易按照双方平等、市场经济原则开展，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（二）本保荐机构的核查意见

通富微电与富士通半导体株式会社之间的关联交易，符合通富微电业务开展的实际需要。交易定价遵循了公平、公正的原则，没有损害上市公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经保荐代表人核查，通富微电与富士通半导体株式会社之间的关联交易，交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- （二）WLP 技术许可协议；
- （三）保荐机构意见；
- （四）独立董事的独立意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2011年6月9日